

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. КАРАЗІНА
НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР МОН та НАН УКРАЇНИ
КОНЦЕРН “ЦЕНТР НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ”
ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

**Физическая
инженерия
поверхности**

ВИДАЄТЬСЯ 4 РАЗИ НА РІК

**Фізична
інженерія
поверхні**

ЗАСНОВАНИЙ У 2002 РОЦІ

**Physical
surface
engineering**

Том 3, № 3–4, липень – грудень 2005

ХАРКІВ

Засновники:

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Науковий фізико-технологічний центр Міністерства освіти і науки України
та Національної академії наук України
Концерн “Центр нових технологій” Харківський фізико-технічний інститут

Видається за рішеннями:

Вченої ради Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
протокол № 11 від 29 грудня 2005 р.

Вченої ради Наукового фізико-технологічного центру
протокол № 3 від 27 грудня 2005 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9214 від 29.09.04 р.

© Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2005

© Науковий фізико-технологічний центр, оригінал-макет, 2005

© Концерн “Центр нових технологій” Харківський фізико-технічний інститут, 2005

<i>А.Д. Погребняк, Ш.М. Рузимов, О.П. Кульментьева, В.С. Русаков, Д.Л. Алонцева, К.А. Дядюра, В.В. Понарядов. Характеристики и свойства защитных покрытий на основе Ni-Cr и Co-Cr после обработки концентрированными потоками энергии</i>	158
<i>Б.П. Грищенко, Н.А. Погребняк, М.К. Кылышканов, А.Д. Погребняк, С.М. Дуванов, В.В. Понарядов. Триплексная обработка покрытий из Al-Ni</i>	190
<i>Ю.В. Кунченко, В.В. Кунченко. Модель формирования слоистой структуры покрытий, получаемых методом вакуумно-дугового осаждения</i>	199
<i>В.В. Мороз. Применение искусственной турбулизации пограничного слоя воздушного потока в электродуговом напылении</i>	208
<i>S.V. Dudin, V.I. Farenik, A.N. Dahov, J. Walkowicz. Development of arc suppression technique for reactive magnetron sputtering</i>	211
<i>У.М. Бузруков. Исследование фоточувствительности двухбарьерной pAlGaInAs-nGaAs:O-Au-структуры</i>	216
<i>Ю.Ю. Вайткус, Н.Х. Юлдашев, С.М. Отажонов. О механизме образования высоковольтной фото-ЭДС в тонких косонапыленных пленках CdTe:Ag при собственном и примесном поглощении</i>	219
<i>М.А. Каримов, Н.Х. Юлдашев. Влияние примеси индия на фото-вольтаические свойства косонапыленных пленок CdTe</i>	228
<i>Д.М. Ёдгорова. Исследование зависимости выходных характеристик олевого транзистора от параметров управляющего перехода</i>	232
<i>Б.М. Широков, А.Ф. Корж. Дисперсные поглотители электромагнитных волн</i>	235
<i>Б.М. Широков, А.Ф. Корж. Когерентное взаимодействие. Дисперсные поглотители электромагнитных волн</i>	238
<i>В.В. Петухов, В.А. Коновалов, Д.Н. Терпий, Е.А. Клеваник, Д.М. Малиненко. Влияние режимов распыления и геометрии распылительной системы на толщину и состав получаемых пленок</i>	241
<i>М.И. Дзюбенко, С.Н. Колтаков, А.В. Нестеров, В.П. Пелипенко, А.А. Приёмко. Изучение особенностей выброса металла при лазерной гравировке</i>	245
<i>Правила оформления статей</i>	250
<i>Правила оформления статей</i>	251
<i>Information for authors</i>	252